
회로이론 복습

아날로그 신호와 디지털 신호

□ 아날로그 신호(Analog Signal)

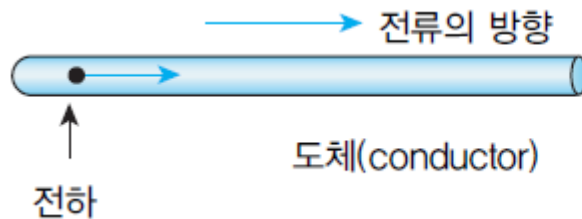
- 연속적인 물리량
- (예) 빛의 밝기, 소리의 높낮이나 크기, 바람의 세기 등
- 아날로그 신호는 정보와 신호의 관점에서의 구분하여 표현
 - 정보 관점 : 음성, 영상 신호 등과 같이 실생활에서 다루는 대부분의 정보 신호의 표현
 - 신호 관점 : 시간에 따라 크기와 패턴이 계속해서 바뀌는 전자기파나 사인파 등과 같은 신호에 대한 표현

□ 디지털 신호(Digital Signal)

- 이산적(discrete)인 물리량
 - 정보 관점: 문자, 정수, on/off, 0/1(비트), 옥텟(바이트) 정보에 대한 표현
 - 신호 관점: 불연속적인 신호 변화나 이진펄스(binary pulse) 정보 등과 같은 표현

전류

□ 도체의 전하 흐름과 전류 방향의 관계



[그림 2-2] 도체의 전하 흐름과 전류 방향의 관계

- 전하: q 로 표기, 단위 [Coulomb] 또는 [C], 쿨롬이라고 읽는다.
- 전하가 흐르는 방향은 전류의 방향과 같지만, 핵 안의 자유전자가 흐르는 방향과는 정반대다.
- 전하의 흐름 = 전류의 흐름
- 전류

$$i(t) = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \quad (2.1)$$

전류

□ 일정 시간 동안 움직인 전하의 양

- 주어진 전류 함수를 일정 시간까지 적분하여 얻을 수 있다.

$$q(t) = \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (2.2)$$

전압

□ 전압(voltage)

- 전하의 위치에너지를 뜻한다.
- 단위로 [Volt] 또는 [V]를 사용한다.
- +전하가 -전하 쪽으로 흐르려고 하는 힘

□ 전압 v

- 단위 전하량에 의하여 변환된 에너지의 양으로 표시할 수 있다.
- 단위 [Volt] = [V]는 식에 의해 [Joule/Coulomb] = [J/C]로 표기할 수 있다.

$$v = \frac{w}{q} = \frac{\text{[변환된 에너지]}}{\text{[전하량]}} = [\text{V}] = [\text{J/C}] \quad (2.3)$$

전력

□ 순간전력 $p(t)$

- 전압을 $v(t)$, 전류를 $i(t)$ 라면, 시간 t 에서 소자에 발생하는 순간전력 $p(t)$ 는 식(2.4)와 같다.

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (2.4)$$

$$v=w/q \quad i=q/t$$

$$p=v \times i=w/q \times q/t=w/t$$

전력

□ 전력의 단위

- [Watt] 또는 [W]

$$[\text{Volt}] \cdot [\text{Ampere}] = \frac{[\text{J}]}{[\text{C}]} \cdot \frac{[\text{C}]}{[\text{s}]} = [\text{J/s}] = [\text{Watt}]$$

□ 일

- 전력은 단위 시간당 에너지, 즉 일의 양이다.
- 전력을 일정 시간 동안 적분하면 에너지(일)를 얻을 수 있다.
- t_0, t_1 사이 시간 동안 소비된 에너지의 양 – 식 (2.5)

$$w(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} p(\tau) d\tau \quad (2.5)$$

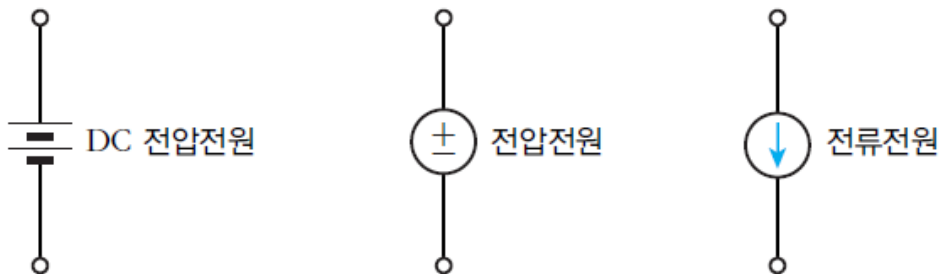
전원

□ 전원

- 전력 혹은 에너지를 공급하는 능동소자
- 전력공급소자의 대표적 소자
- 에너지를 공급하는 방법에 따라 독립전원과 종속전원으로 분류
- 공급되는 전원에 따라 전류전원과 전압전원으로 분류

□ 독립전원

- 다른 소자의 에너지 값에 상관없이 그 자체가 가지고 있는 에너지를 직접 또는 독립적으로 공급하는 전원
- 대표적인 예: 건전지

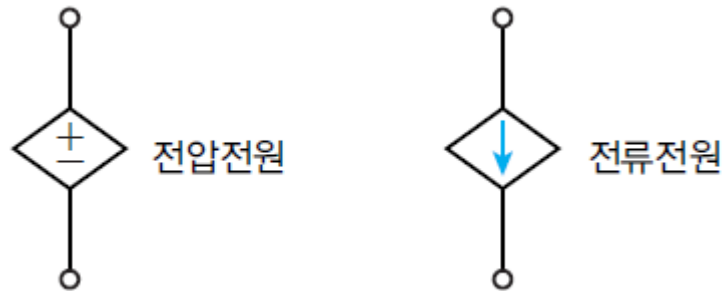


[그림 2-15] 독립전원의 회로적 표현

전원

□ 종속전원

- 다른 소자에 흐르는 전류의 값이나 혹은 전압의 값에 따라 회로적으로 이 값에 의하여 조정되어 공급되는 전원
- 예: 전자회로에서 트랜지스터를 동작하려고 회로적으로 공급하는 바이어스 전압, 트랜지스터의 등가회로 등에서 볼 수 있는 전원
- 공급되는 전원에 따라 전류전원과 전압전원으로 분류

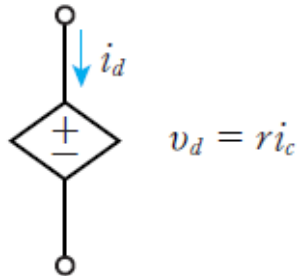


[그림 2-16] 종속전원의 회로적 표현

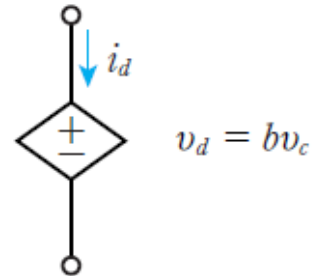
- 공급되는 전원의 종류에 따라 종속전압전원과 종속전류전원으로 나뉨
- 조정하는 다른 소자의 값이 전류 값인지 전압 값인지에 따라서도 나뉨

전원

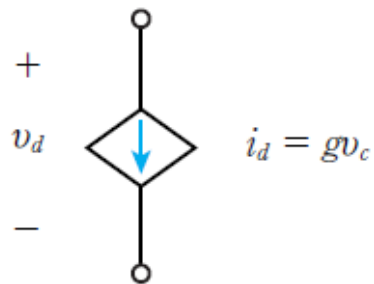
□ 네 가지 형태의 종속전원



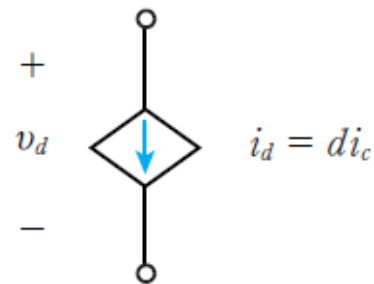
(a) CCVS (Current Controlled Voltage Source:
전류조정 전압전원)



(b) VCVS (Voltage Controlled Voltage Source:
전압조정 전압전원)



(c) VCCS (Voltage Controlled Current Source:
전압조정 전류전원)



(d) CCCS (Current Controlled Current Source:
전류조정 전류전원)

[그림 2-17] 네 가지 종류의 종속전원

선형회로

□ 선형시스템의 특징

- 중첩의 원리

□ 선형성

- 임의의 시스템 f 의 입력(x)과 출력($y = f(x)$)의 관계가 식 (1.1)과 같으면 이 시스템은 **선형성**을 가진다.

□ 중첩의 원리

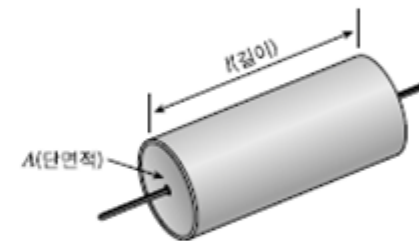
- $f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2)$ (1.1)

수동소자 R, L, C

□ 저항

- 전류의 흐름을 방해하는 정도
- 길이에 (l)에 비례, 단면적(A)에 반비례하고, 이것을 수식으로 나타내면 다음과 같음

$$R = \rho \frac{l}{A}$$



[그림1-6] 저항의 외형과 구조

- 탄소피막저항
 - 세라믹 봉(ceramic rod)에 피막 형태로 탄소분말을 입힌 다음 나선형으로 홈을 파서 제작.



수동소자 R, L, C

□ 가변저항 (볼륨저항)

- 저항값의 변경 가능
- 전위차계(potentiometer) : 기어(gear)를 조합하여 회전에 따라 저항 값을 세밀하게 조정 가능함



[그림 1-9] 가변저항을 사용하는 전위차계

□ 저항의 symbol



(a) 일반저항



(b) 가변저항

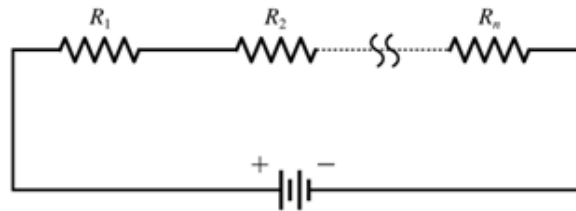
[그림 1-10] 저항의 기호

수동소자 R, L, C

□ 저항의 직,병렬 연결

• 직렬연결

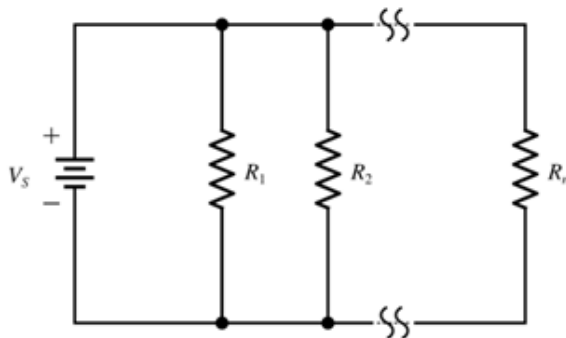
$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$



[그림 1-11] 직렬회로의 합성저항

• 병렬연결

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$



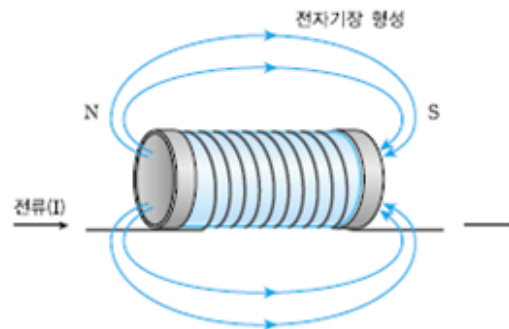
[그림 1-12] 병렬회로의 합성저항

수동소자 R, L, C

□ 인덕터

- 구리나 알루미늄 등을 절연성 재료로 감싼 다음, 그 둘레를 도선으로 감아 놓은 형태의 소자 (코일(Coil))
- 인덕터에 전류가 흐르게 하면 자기장이 형성되고 전류를 변화시키면 전자기장도 변화
- 전자기장이 변화하면 전류의 변화를 방해하는 방향으로 코일 내에 유도전압이 발생하며 이것을 인덕턴스(L)라고 함
- 코일의 인덕턴스(L)와 전류의 시간변화율은 유도전압을 결정

$$v = L \frac{di}{dt}$$



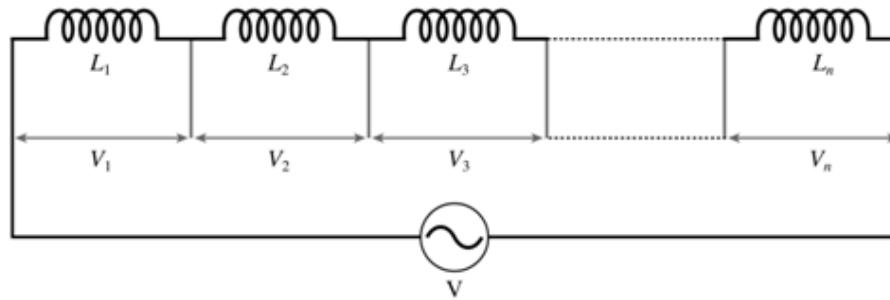
[그림 1-13] 기본적인 인덕터의 구조

수동소자 R, L, C

□ 인덕터의 직,병렬 연결

• 직렬연결

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n$$

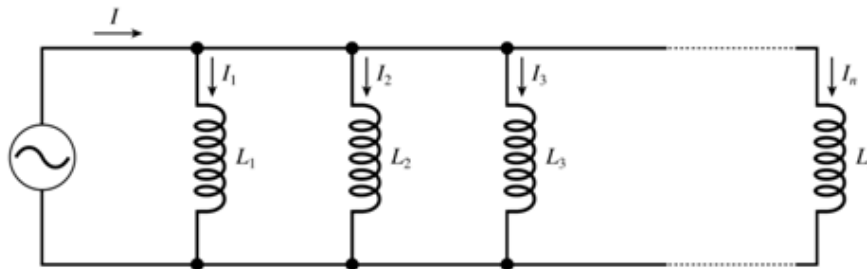


[그림 1-15] 인덕터의 직렬연결

• 병렬연결

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_n}$$

$$L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$



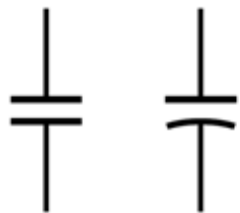
[그림 1-16] 인덕터의 병렬연결

수동소자 R, L, C

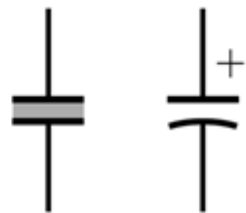
□ 캐패시터

- 두 도체 사이의 공간에 전하를 모으는 소자
- 두 개의 도체판으로 구성 그 사이로 절연체가 들어감
- 각 판의 표면과 절연체의 경계 부분에 전하가 축적되고, 양 표면에 모이는 전하량의 크기가 같지만 부호는 반대
- 캐패시터의 전기용량은 전하량과 전위차로 나타낼 수 있음
- 정전용량 C, 전하량 Q, 전위차 V

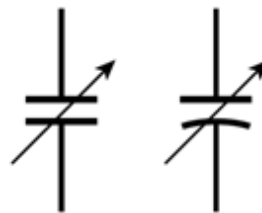
$$C = \frac{Q}{V}$$



(a) 커패시터



(b) 전해 커패시터



(c) 가변 커패시터



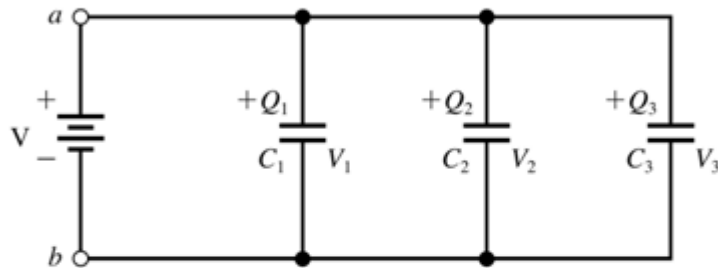
(d) 트리머 커패시터

[그림 1-17] 커패시터의 종류

수동소자 R, L, C

□ 캐패시터의 병렬연결

- 정전용량을 증가시키기 위해서는 병렬로 연결해야 함



[그림 1-19] 커패시터의 병렬연결

$$Q_1 = C_1 V, \quad Q_2 = C_2 V, \quad Q_3 = C_3 V$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = (C_1 + C_2 + C_3)V$$

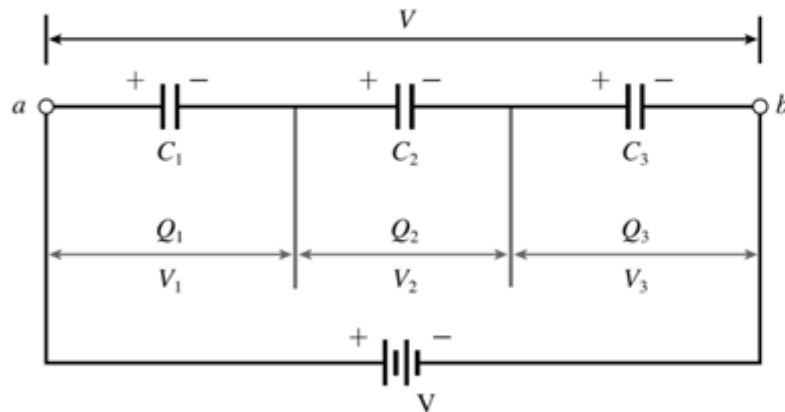
- 병렬연결시 총용량

$$C_T = \frac{Q_T}{V} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3)V}{V} = C_1 + C_2 + C_3$$

수동소자 R, L, C

□ 커패시터의 직렬연결

- 직렬로 연결하면 총용량이 감소함



[그림 1-20] 커패시터의 직렬연결

$$Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1}, V_2 = \frac{Q_2}{C_2}, V_3 = \frac{Q_3}{C_3}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_3}{C_3} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) Q_T$$

$$C_T = \frac{Q_T}{V} = \frac{Q_T}{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) Q_T} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

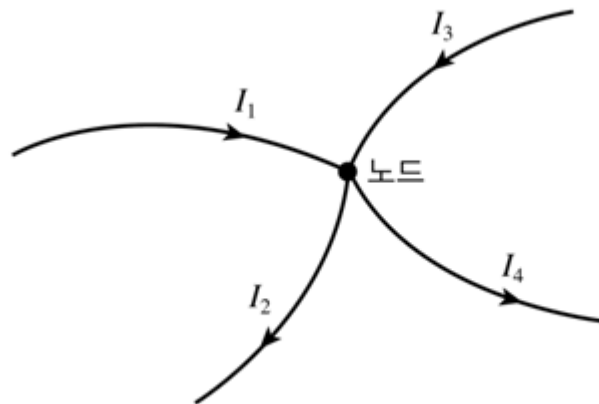
$$V_1 : V_2 : V_3 = \frac{Q_1}{C_1} : \frac{Q_2}{C_2} : \frac{Q_3}{C_3} = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} : \frac{1}{C_3}$$

KCL, KVL, 옴의 법칙

□ 키르히호프의 전류 법칙(KCL)

- 전하보존법칙에 근거하여 전류의 연속성을 나타내는 법칙.
- 회로내의 임의의 노드에 들어오는 전류와 나가는 전류는 '0'이 됨

$$I_1 + (-I_2) + (-I_3) + (I_4) = 0$$

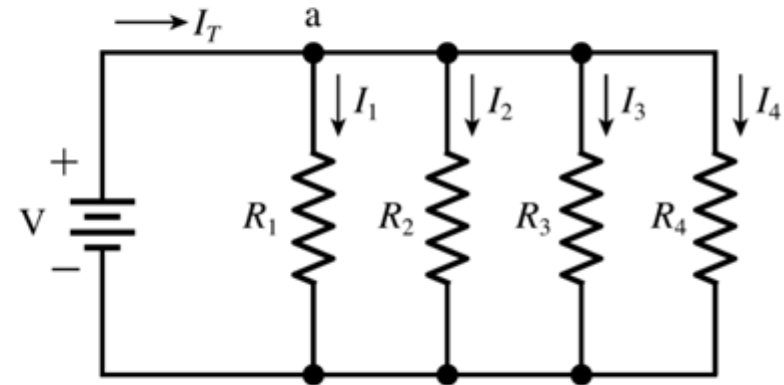


[그림 1-21] 키르히호프의 전류법칙

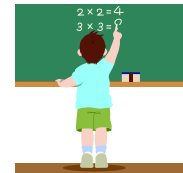
KCL, KVL, 옴의 법칙

예제 1-1

다음 [그림 1-22] 회로에서 $I_T = 30\text{ A}$, $I_1 = 5\text{ A}$, $I_2 = 10\text{ A}$, $I_4 = 7\text{ A}$ 일 때, I_3 을 구하라.



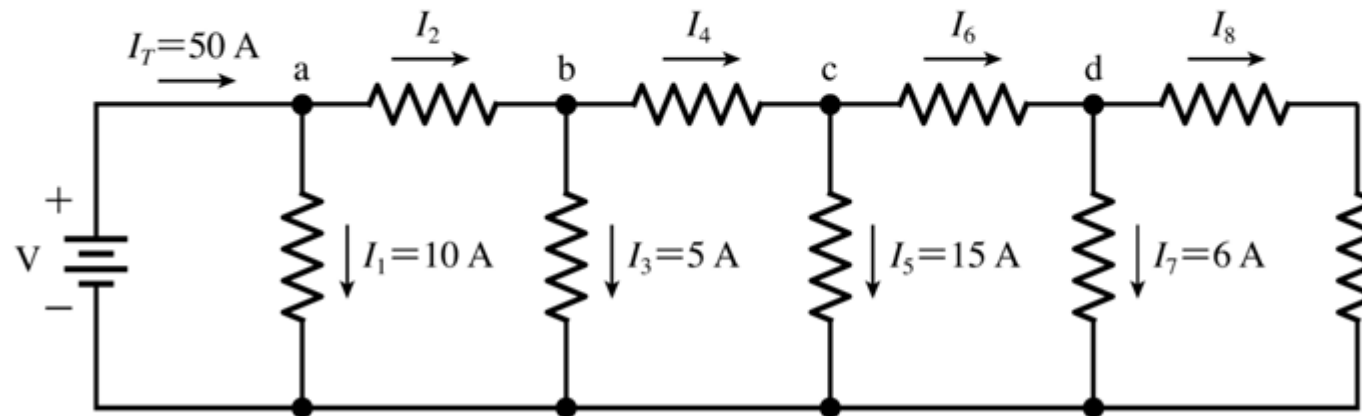
[그림 1-22]



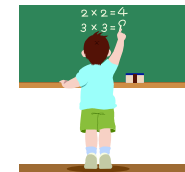
KCL, KVL, 옴의 법칙

예제 1-2

다음 [그림 1-23]의 회로에서 전류 I_2 , I_4 , I_6 을 구하라.



[그림 1-23]



KCL, KVL, 옴의 법칙

□ 키르히호프의 전압법칙(KVL)

- 에너지 보존 법칙에 근거한 법칙으로 임의의 폐회로를 한 방향으로 움직이면서 취한 전압은 0' 이라는 것을 명시
- 이동방향으로의 전압상승은 (+)로 표기, 전압강하는(-)로 표기
- 키르히호프의 전압 법칙은 다음과 같이 3가지로 표현 가능

- ① 전압 상승의 합은 영이다. (전압 상승의 합 = 0)

$$V_1 - V_2 + V_3 - V_4 = 0$$

- ② 전압 강하의 합은 영이다. (전압 강하의 합 = 0)

$$-V_1 + V_2 - V_3 + V_4 = 0$$

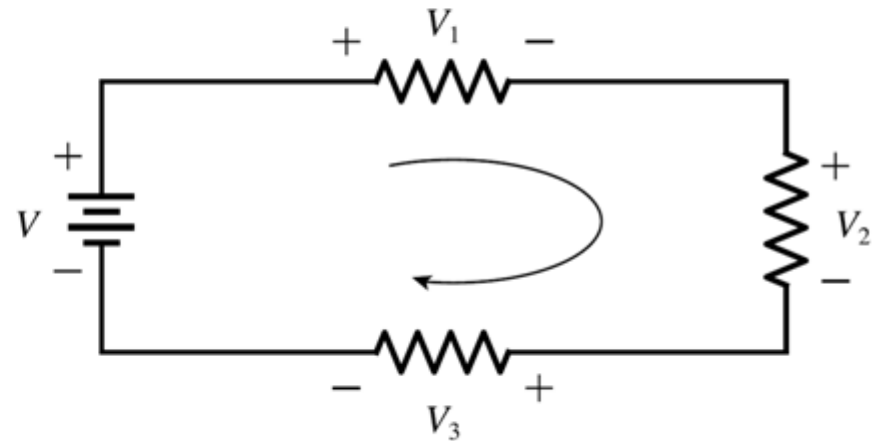
- ③ 각 소자에서 (+)부호가 붙은 단자에서는 (+)로, (-)부호가 붙은 단자에서는 (-)로 계산.

$$-V_1 + V_2 - V_3 + V_4 = 0$$

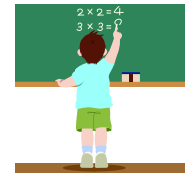
KCL, KVL, 옴의 법칙

예제 1-3

[그림 1-25]의 회로에서 $V_1=2\text{ V}$, $V_2=5\text{ V}$, $V_3=3\text{ V}$ 일 때, 인가전압 V 를 구하라.



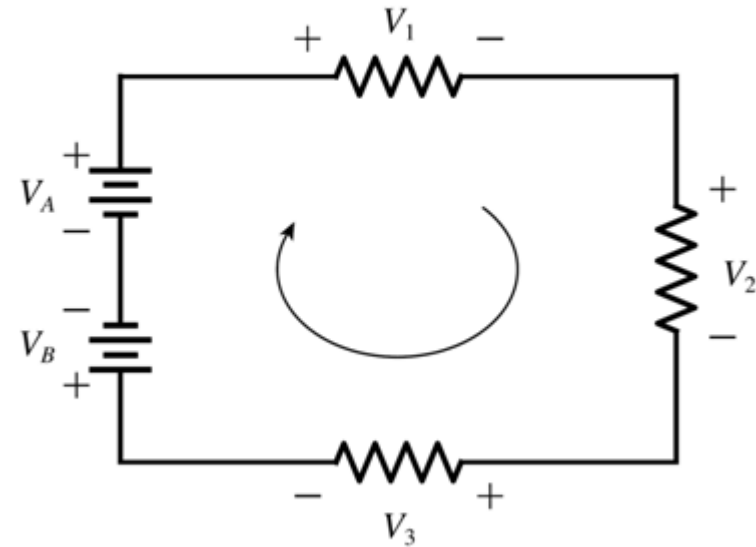
[그림 1-25]



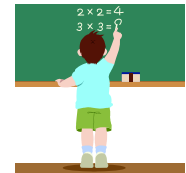
KCL, KVL, 옴의 법칙

예제 1-4

[그림 1-26]의 회로에서 $V_A=35\text{ V}$, $V_B=5\text{ V}$, $V_2=12\text{ V}$, $V_3=10\text{ V}$ 일 때, V_1 전압을 구하라.



[그림 1-26]



KCL, KVL, 옴의 법칙

□ 옴의 법칙

- 전압의 세기를 볼트(Volt), 전류의 세기를 암페어(Ampere), 저항을 옴(Ohm)으로 나타냄.

$$V = IR$$

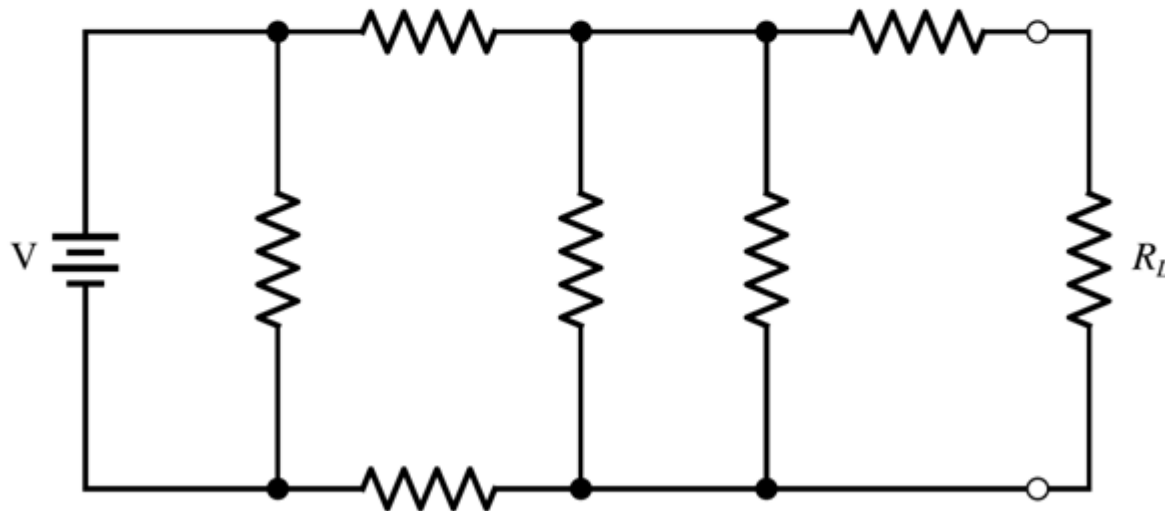
- 저항 R에 전류 I가 흐를때 저항 양단에 두 인수의 곱한 크기의 전압강하가 발생한다는 의미
- 전압은 전류와 관계

$$I = \frac{V}{R} = GV \text{ A}$$

테브넵 등가회로

□ 테브넵의 정리

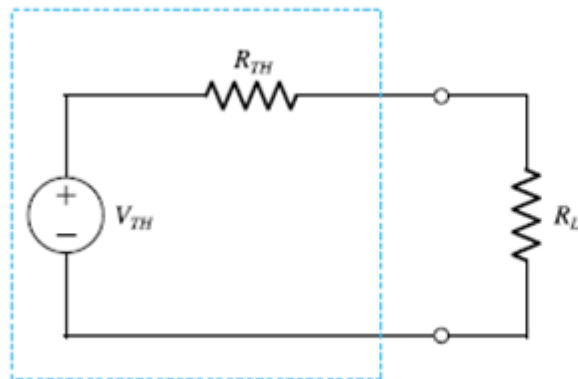
- 두 개의 단자를 지닌 전압원, 전류원, 저항 등의 어떤 조합이라도 테브넵 전압원 V_{TH} 와 테브넵 저항 R_{TH} 을 직렬로 연결한 등가회로로 대체할 수 있음.



[그림 1-27] 전압 V 와 부하저항 R_L 사이에 저항이 복잡하게 연결된 회로의 예

테브넵 등가회로

- 부하 저항 R_L 을 제외한 나머지 소자를 전압원 V_{TH} 와 저항 R_{TH} 로 바꾼 다음 부하저항에 연결
- 테브넵 등가전압 (V_{TH})은 부하저항을 개방상태로 한 다음, 부하의 양단에 걸리는 등가전압을 의미함
- 테브넵 등가저항 (R_{TH})은 회로에서 전압원을 단락시키고(전류원인 경우는 개방) 부하 쪽에서 바라다 본 등가저항을 말함

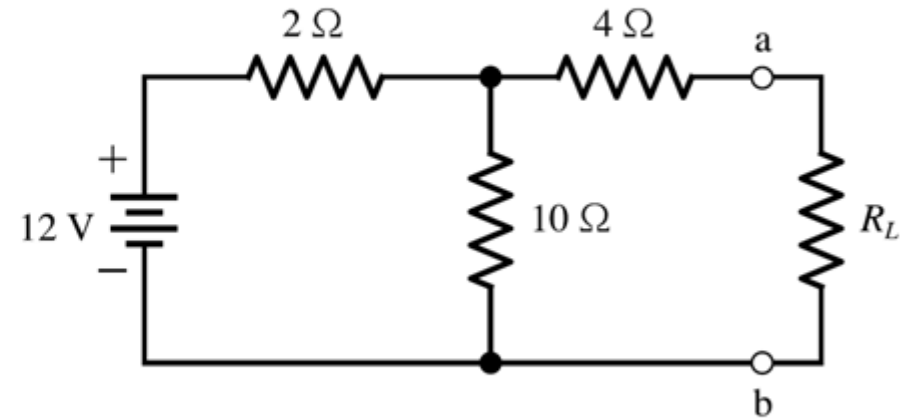


[그림 1-28] 테브넵 등가회로

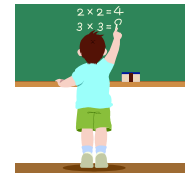
테브넵 등가회로

예제 1-5

[그림 1-29]의 회로를 테브넵 등가전압 V_{TH} 와 테브넵 등가저항 R_{TH} 를 이용하여 테브넵 등가회로로 대체하라.



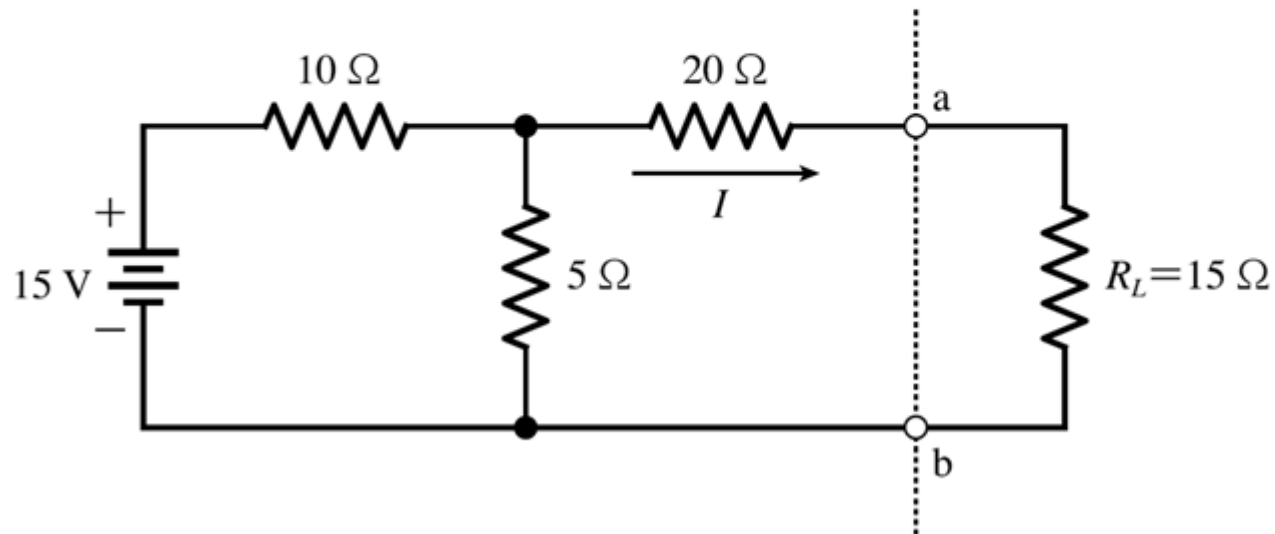
[그림 1-29]



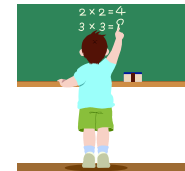
테브넵 등가회로

예제 1-6

[그림 1-31]의 회로에서 테브넵 정리를 이용하여 부하저항 R_L 에 흐르는 전류 I 를 구하라.

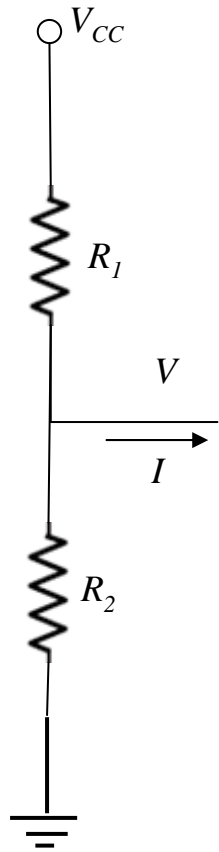


[그림 1-31]



테브닌 정리 검증

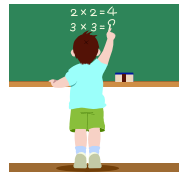
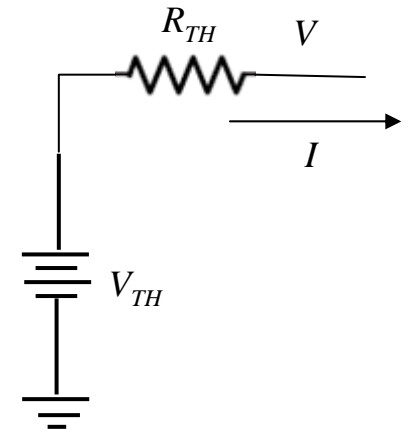
아래 회로의 V 를 구하라.



$$I = \frac{V_{CC} - V}{R_1} - \frac{V}{R_2} = \frac{V_{CC}R_2 - VR_2 - VR_1}{R_1R_2}$$

$$= \frac{V_{CC}R_2}{R_1R_2} - \frac{V(R_1 + R_2)}{R_1R_2}$$

$$V = V_{CC} \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} - I \frac{R_1R_2}{(R_1 + R_2)} = V_{TH} - I \cdot R_{TH}$$

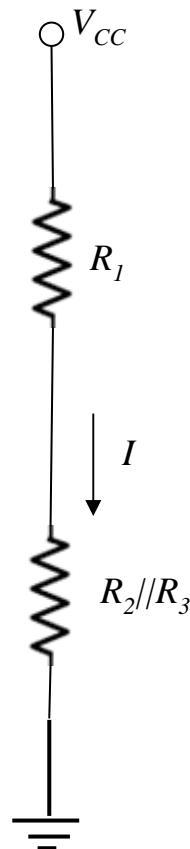
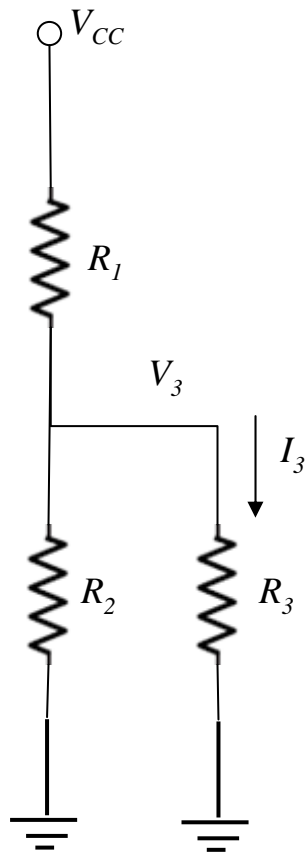


테브닌 정리 검증

아래 저항 R_3 에 흐르는 전류 I_3 을 구하시오. $R_1=R_2=R_3=1, V_{CC}=1V$

R_2 와 R_3 를 병렬저항으로 대체하면,

테브닌 등가회로로 대체하면,



$$I = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

$$I_3 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

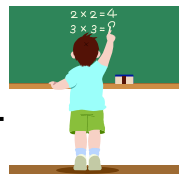
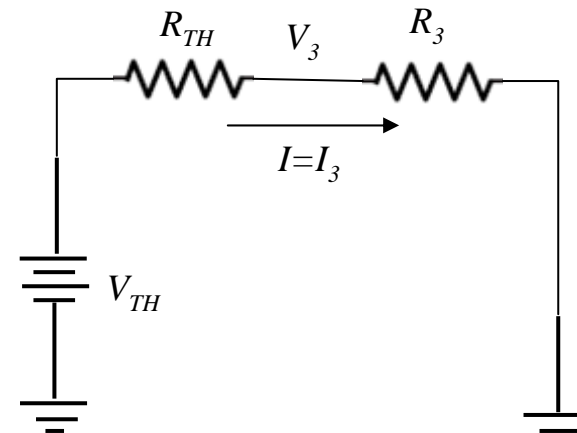
$$V_3 = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \times V_{CC} = \frac{1}{3}$$

$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CC} = \frac{1}{2}$$

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = \frac{1}{2}$$

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_3} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3}$$

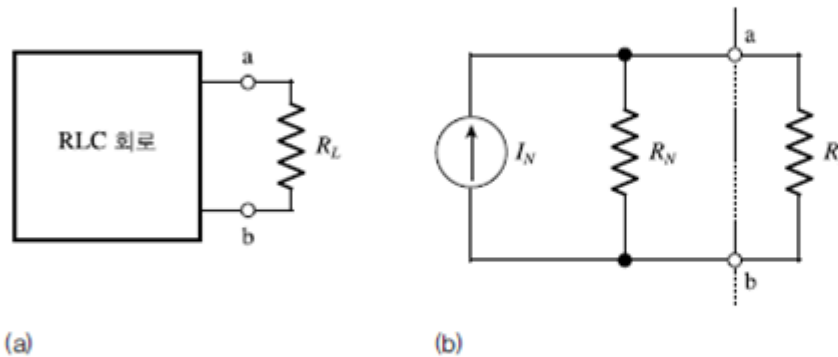
$$V_3 = V_{TH} - I \times R_{TH} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$



노턴 등가회로

□ 노턴의 정리

- 테브닝의 정리와 함께 복잡한 회로를 간략화하여 해석하는데 사용
- 두 개의 단자를 지닌 소자의 조합을 노턴 등가 전류원 I_N 과 노턴 등가저항 R_N 을 병렬로 연결한 등가회로가 노턴 등가회로임



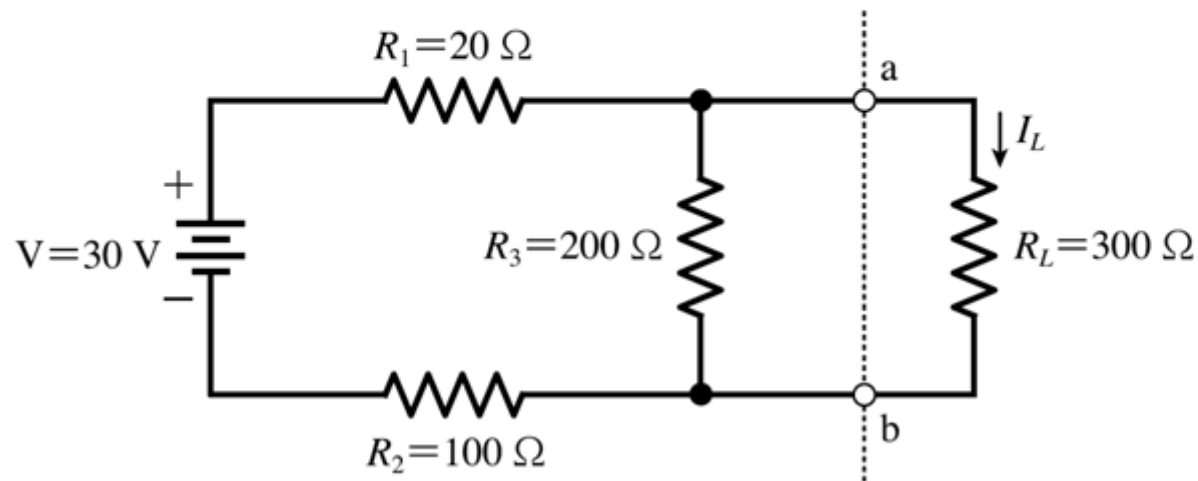
[그림 1-34] (a) 일반적인 RLC 회로, (b) 노턴 등가회로

- 부하 저항을 없애고 단자a와 단자b 사이를 단락, 단락된 곳에 흐르는 전류를 계산하면 노턴 등가전류가 됨
- 부하 저항을 없애고 회로 쪽에서 바라본 저항이 노턴 등가저항임

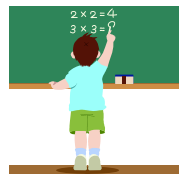
노턴 등가회로

예제 1-7

[그림 1-35]의 회로에서 노턴의 정리를 이용하여 부하저항 R_L 에 흐르는 전류 I_L 을 구하라.



[그림 1-35]



메쉬 해석법

$$R_{11}I_1 + R_{12}I_2 + R_{13}I_3 = \sum V_1$$

$$R_{21}I_1 + R_{22}I_2 + R_{23}I_3 = \sum V_2$$

$$R_{31}I_1 + R_{32}I_2 + R_{33}I_3 = \sum V_3$$

R_{ii} : i 번째 전류가 흐르는 메쉬의 저항을 모두 더한 값

$R_{ij}(i \neq j)$: i 번째 메쉬와 j 번째 메쉬가 겹치는 가지에 있는 저항의 합으로 그 결과에 항상 (-)부호를 붙인다.

$\sum V_i$: i 번째 메쉬를 시계 방향으로 일주하면서 전압 상승인 전원은 (+), 전압 강하인 전원은 (-)로 더한 값

메쉬 해석법

[예제 3-2] 그림 3-6 회로에서 전류 $I[A]$ 를 구하시오.

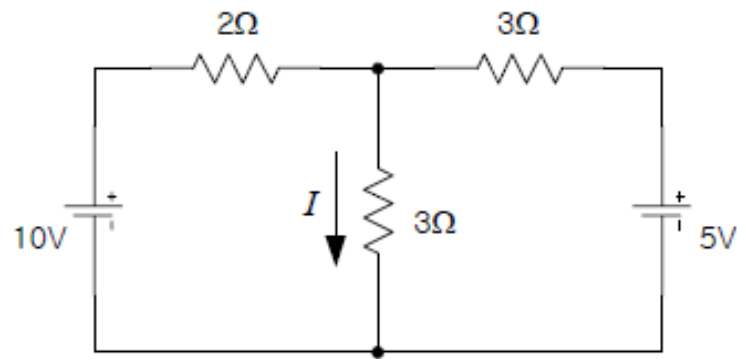
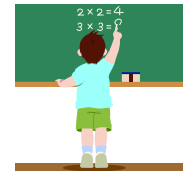


그림 3-6



노드 해석법

$$G_{11} V_1 + G_{12} V_2 + G_{13} V_3 = \sum I_1$$

$$G_{21} V_1 + G_{22} V_2 + G_{23} V_3 = \sum I_2$$

$$G_{31} V_1 + G_{32} V_2 + G_{33} V_3 = \sum I_3$$

G_{ii} : i 번째 노드에 연결된 가지의 컨덕턴스의 합

$G_{ij} (i \neq j)$: i 번째 노드와 j 번째 노드를 다른 노드를 거치지 않고 직접 연결하는 가지에 있는 컨덕턴스를 더한 값으로 그 결과에 항상 (-)부호를 붙인다.

$\sum I_i$: i 번째 노드에 연결된 전류 전원 중에서 들어오는 방향의 전원은 (+), 나가는 방향의 전원은 (-)로 더한 값

노드 해석법

[예제 3-6] 그림 3-18 회로에 노드 해석법을 이용하여 전류 I 를 구하시오.

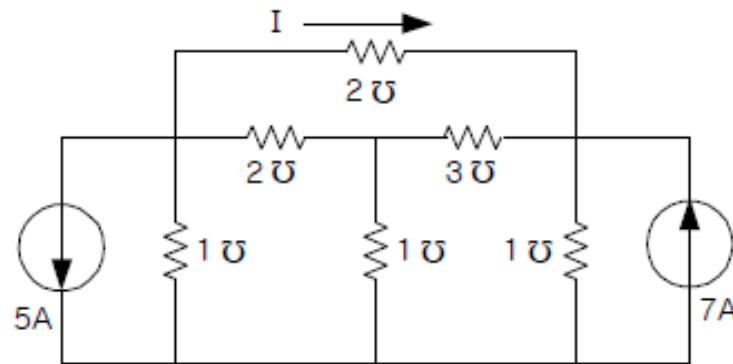


그림 3-18



인덕터(inductor)

패러데이(Faraday) 법칙: 인덕턴스 $L[H]$ 인 인덕터에 전류 $i[A]$ 가 흐르면 그 양단에 전압이 유도되며, 이 전압은 전류가 흐르는 것을 방해하기 때문에 역기전력 또는 유도 기전력이라 부른다.

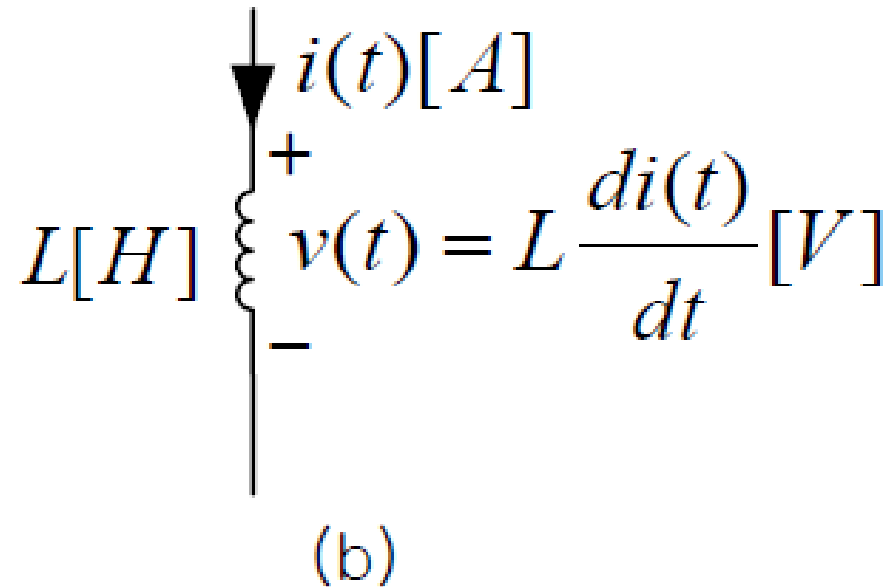


그림 4-3

커패시터

커패시터(Capacitor): 두 개의 금속판 사이에 절연 재료로 만들어진 유전체를 샌드위치처럼 끼워놓은 회로 소자. 커패시터는 콘덴서(condenser)라 부르기도 하며, 회로에서는 전하를 저장하는 역할을 한다.

인덕터가 전류에 의한 자기장을 만드는 것과 비슷하게 커패시터는 유전체를 통하여 전기장을 만든다.

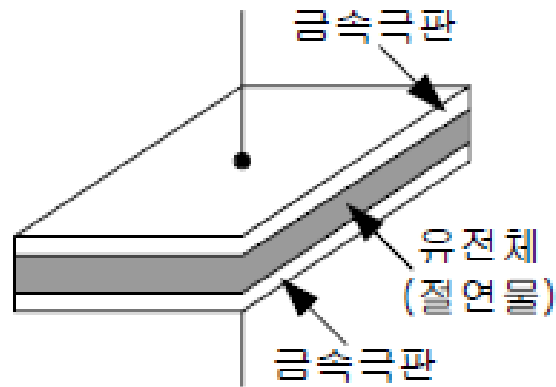


그림 4-10

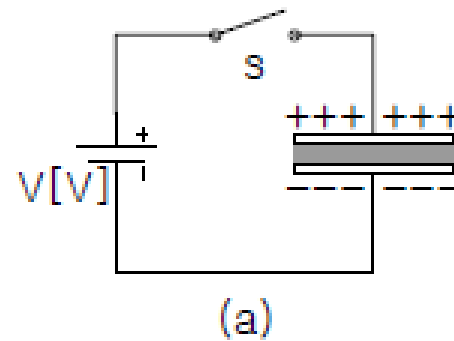
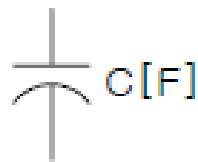
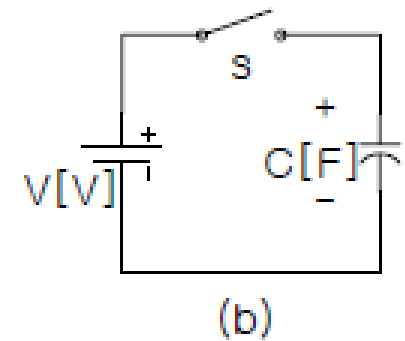


그림 4-11



커패시터

일반적인 커패시터의 용량 C 는 극판의 면적 A 및 유전체의 비유전률 ϵ_r 에 비례하고 극판 사이의 간격 d 에 반비례한다. (ϵ_0 는 진공의 유전률)

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} = \epsilon \frac{A}{d} [F]$$

커패시터에 축전되는 전하는 커패시터에 걸어준 전압의 크기에 비례한다.

$$Q = CV [C]$$

커패시터

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(Cv)}{dt} = C \frac{dv}{dt} [A]$$

$$i dt = C dv \rightarrow dv = \frac{1}{C} i dt$$

$$\int dv = v = \frac{1}{C} \int_{t_a}^t i dt + v(t_a)$$

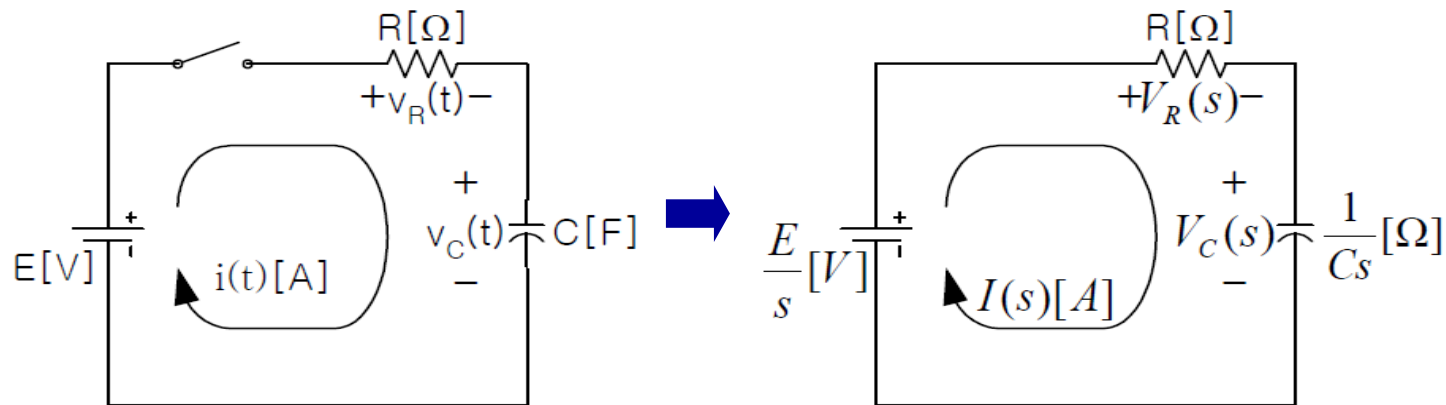
일반화된 임피던스와 라플라스 변환

초기값이 0인 경우, 미분방정식을 거치지 않고 바로 라플라스 변환된 방정식 구하기

$$R \rightarrow R$$

$$L \rightarrow sL$$

$$C \rightarrow 1/sC$$



$$Z(s) = R + 1/Cs [\Omega]$$

$$I(s) = \frac{E/s}{Z(s)} = \frac{E/s}{R + 1/Cs} = \frac{E}{Rs + 1/C} = \frac{E/R}{s + 1/RC} \rightarrow i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} [A]$$